Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/017884

International filing date: 01 December 2004 (01.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2003-401382

Filing date: 01 December 2003 (01.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 27 January 2005 (27.01.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年12月 1日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-401382

[ST. 10/C]:

[JP2003-401382]

出 願 人
Applicant(s):

日本特殊陶業株式会社

2004年12月10日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office n, 11]



【書類名】 特許願 【整理番号】 103-0628 【提出日】 平成15年12月 1日 【あて先】 特許庁長官 殿 【国際特許分類】 H01L 23/02 【発明者】 【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式会 社内 【氏名】 勝田 隼人 【発明者】 【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式会 社内 【氏名】 神山 雄一 【発明者】 【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式会 社内 【氏名】 服部 洋一 【発明者】 【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式会 社内 【氏名】 小島 多喜男 【特許出願人】 【識別番号】 000004547 【氏名又は名称】 日本特殊陶業株式会社 【代理人】 【識別番号】 100104178 【弁理士】 【氏名又は名称】 山本 尚 【電話番号】 052-889-2385 【選任した代理人】 【識別番号】 100119611 【弁理士】 【氏名又は名称】 中山 千里 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 052478 【納付金額】 21,000円 【提出物件の目録】 【物件名】 特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書 1 【物件名】 図面 1

【物件名】

要約書 1

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

配線基板と、当該配線基板の表面に搭載されるセンサ素子と、当該センサ素子を覆うように前記配線基板に装着される保護キャップとを備えたセンサ素子実装パッケージであって、

前記配線基板は、積層構造を有し、且つ、当該積層構造の外側面のうち前記配線基板の最表面となる表面最外層以外の層の外側面に窪み部を備え、

前記保護キャップは、前記配線基板の外側面に沿うように垂下突起部が形成され、且つ、当該垂下突起部には前記窪み部に嵌合する嵌合突起が形成されている ことを特徴とするセンサ素子実装パッケージ。

【請求項2】

前記窪み部は、少なくとも前記配線基板の前記外側面のうちの対向する2面に設けられていることを特徴とする請求項1に記載のセンサ素子実装パッケージ。

【請求項3】

前記配線基板の前記外側面には、前記窪み部に前記嵌合突起が嵌合する位置まで前記垂 下突起部を案内する案内凹部が設けられていることを特徴とする請求項1又は2に記載の センサ素子実装パッケージ。

【書類名】明細書

【発明の名称】センサ素子実装パッケージ

【技術分野】

[0001]

本発明は、センサ素子実装パッケージに関し、詳細には、配線基板に保護キャップを嵌合させたセンサ素子実装パッケージに関する。尚、本発明は、シリコンの微細加工技術を用いたマイクロガスセンサを備えたセンサ素子実装パッケージに有用である。

【背景技術】

[0002]

従来、センサ素子や半導体素子を実装するパッケージとしては、周囲又は裏面に端子を 形成した配線基板の上面に半導体素子の搭載部を形成すると共にその周囲に周囲枠を形成 し、その周囲枠の上面に全周にわたる円形の溝を形成し、保護キャップの垂下突起部を前 記溝に嵌合した半導体素子実装パッケージが知られている(例えば、特許文献1参照)。 この半導体素子実装パッケージでは、保護キャップの垂下突起部は、接着剤により、周囲 枠の溝に接着して保護キャップを封止する場合が多かった。

【特許文献1】特開昭62-98647号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0003]

しかしながら、特許文献1に記載の半導体素子実装パッケージでは、組み立て工程において、保護キャップの垂下突起部を配線基板の周囲枠の溝に接着する場合には、まず、接着剤を周囲枠の溝に塗布し、その後、垂下突起部を周囲枠に接着して接着剤を固化させているために、保護キャップを配線基板の周囲枠に嵌合させる工程以外にも、上記接着剤の塗布工程や接着剤の固化の工程があり、組み立て工程の工数が増加するという問題点があった。このことは、センサ素子でも同様である。

[0004]

本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであり、配線基板に対する保護キャップの装着工程が複雑化せず、配線基板に保護キャップを容易に装着することができるセンサ素子実装パッケージを実現することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0005]

上記の課題を解決するために請求項1に記載の発明のセンサ素子実装パッケージは、配線基板と、当該配線基板の表面に搭載されるセンサ素子と、当該センサ素子を覆うように前記配線基板に装着される保護キャップとを備えたセンサ素子実装パッケージであって、前記配線基板は、積層構造を有し、且つ、当該積層構造の外側面のうち前記配線基板の最表面となる表面最外層以外の層の外側面に窪み部を備え、前記保護キャップは、前記配線基板の外側面に沿うように垂下突起部が形成され、且つ、当該垂下突起部には前記窪み部に嵌合する嵌合突起が形成されていることを特徴とする。

[0006]

また、請求項2に記載の発明のセンサ素子実装パッケージは、請求項1に記載の発明の 構成に加えて、前記窪み部は、少なくとも前記配線基板の前記外側面のうちの対向する2 面に設けられていることを特徴とする。

[0007]

また、請求項3に記載の発明のセンサ素子実装パッケージは、請求項1又は2に記載の発明の構成に加えて、前記配線基板の前記外側面には、前記窪み部に前記嵌合突起が嵌合する位置まで前記垂下突起部を案内する案内凹部が設けられていることを特徴とする。

【発明の効果】

[0008]

請求項1に記載の発明のセンサ素子実装パッケージでは、センサ素子を搭載した積層構造の配線基板のうち、配線基板の最表面となる表面最上層以外の層の外側面に形成された

窪み部に、保護キャップの垂下突起部に形成された嵌合突起を嵌合させて、保護キャップ を配線基板に固定することができる。従って、配線基板に保護キャップを容易に装着でき るので、配線基板に対する保護キャップの装着工程が複雑化しない。

[0009]

また、請求項2に記載の発明のセンサ素子実装パッケージは、請求項1に記載の発明の 効果に加えて、少なくとも配線基板の外側面のうちの対向する2面に設けられている窪み 部に、保護キャップの垂下突起部に形成された嵌合突起を各々嵌合させるので、確実に保 護キャップを配線基板に固定することができる。

[0010]

また、請求項3に記載の発明のセンサ素子実装パッケージは、請求項1又は2に記載の 発明の効果に加えて、配線基板の外側面に設けられた案内凹部により垂下突起部を窪み部 に嵌合突起が嵌合する位置まで案内するので、保護キャップの配線基板への固定が容易に できる。

【発明を実施するための最良の形態】

$[0\ 0\ 1\ 1]$

以下、本発明のセンサ素子実装パッケージをガスセンサ1に適用した一実施の形態につ いて図面を参照して説明する。まず、図1~図3を参照して、ガスセンサ1の外部形状に ついて説明する。図1は本発明の一実施の形態のガスセンサ1の分解斜視図であり、図2 はガスセンサ1の平面図であり、図3はガスセンサ1の底面図である。本発明は、各種の センサ素子や半導体素子を実装するパッケージに適用できるが、本実施の形態のガスセン サ1は、一例として、СОやNО2 を検出するガスセンサを例に説明する。このガスセ ンサ1は、例えば、自動車のエンジンルーム内のフロントグリル近傍に設けられ、空気中 のCOやNO2 を検出して、エアコンの外気導入と内気循環を切り替える空調用センサ に用いられるものである。

[0012]

図1及び図2に示すように、このガスセンサ1は、略直方体形状に形成されており、配 線基板2に形成されたキャビティの開口部を覆うように、配線基板2に保護キャップ3が 、図1において、上方から装着されている。配線基板2は、積層構造となっており、キャ ビティ内にダイヤフラム構造に形成されたガス検出素子8,9が搭載されている。尚、こ のガス検出素子8,9が特許請求の範囲に記載のセンサ素子に相当する。また、保護キャ ップ3は、平面状の頂部30と、頂部30から図1において下方に延びる垂下突起部41 4 2 とを有しており、一例として、ステンレス鋼板のプレス成形により形成される。頂 部30は平面視略長方形に形成されており、頂部30には、被測定ガスがガスセンサ1の 内部(キャビティ内)に入るための平面視、略円形の通気孔31,32,32,33,3 4,35,36,37,38,39が設けられている。また、図3に示すように、ガスセ ンサ1の底面1Aは、略長方形の平面に形成されており、その底面1Aには、図示外の回 路基板と半田付け等により接合される略長方形の外部電極51A,51B,51C,51 D, 51E, 51Fが設けられている。この外部電極51A, 51B, 51C, 51D, 51E, 51Fの表面には、一例としてAuメッキ膜が形成されている。

次に、図1、図3~図5を参照して、ガスセンサ1を構成する配線基板2の構造の詳細 について説明する。図4は、配線基板2の平面図であり、図5は、図4のA-A線断面に 於ける配線基板2の矢視方向断面図である。図1及び図5に示すように、配線基板2は、 図1において、下部から上部に向けて第一層4、第二層5、第三層6、第四層7の4層が 積層されたAl2 〇3 (アルミナ)焼結体からなる平面視略長方形のセラミック積層構造 体である。ここで、本明細書では、配線基板のうちセンサ素子が搭載される側を表面とし 、その反対側を底面とする。即ち、本実施の形態のガスセンサ1の配線基板2(積層構造 体)において、キャビティが形成され、ガス検知素子8,9が搭載される側を表面とし、 その反対側を底面1Aとする。尚、特許請求の範囲に記載の配線基板2の表面とは、表面 から底面に向かう方向に配線基板2を見たときに目視できる部位を意味する。また、本実

施の形態のガスセンサ1においては、第四層7が特許請求の範囲に記載の表面最外層とな る。さらに、配線基板の最表面とは、表面最外層(本実施の形態のガスセンサ1における 第四層7)の表面のことを意味する。尚、積層構造体の第一層4~第三層6の表面には、 図示外の内部配線が形成され、内部配線層を構成している。また、図1及び図4に示すよ うに、配線基板2の長手方向外側面2P及び2Qには、第一層4~第四層7を貫通して、 配線基板2の積層方向に平面視、略円弧状の凹部2C,2D,2E,2F,2G,2H, 2 I, 2 J, 2 K, 2 L, 2 M, 2 Nが各々設けられている。また、配線基板 2 の短手方 向の一方の側面(図1における左側面)2Sには、第一層4~第四層7を貫通して、案内 凹部2Aが設けられ、側面2Sと対向する他方の側面(図1における右側面)2Rにも、 第一層 4 ~第四層 7 を貫通して案内凹部 2 B が設けられている。

[0014]

また、図3及び図5に示すように、最下層の第一層4の短手方向の一方の側面2Sには 、配線基板2の長手方向における前記案内凹部2Aより深い窪みである嵌合部4Aが設け られ、第一層4の右側の側面2Rにも、前記案内凹部2Bより深い窪みである嵌合部4B が設けられている。尚、この嵌合部4A,4Bが本発明の「窪み部」に相当し、配線基板 2の外側面のうちの対向する2面に各々設けられていることになる。これらの嵌合部4A 4 Bには、後述する保護キャップ3の垂下突起部41の嵌合突起41Aと、垂下突起部 42の嵌合突起42Aとが各々進入して嵌合するようになっている。尚、嵌合部は、配線 基板2の外側面のうちの対向する対向する2面に限られず、全ての面に設けても良い。こ の場合には、さらに、嵌合強度が向上する。

[0015]

さらに、図4及び図5に示すように、第二層5の短手方向中央部には、後述するダイア フラム構造内の内圧を調整する内圧調整用窪み5Aが長手方向に延設されている。また、 第三層6の中央付近には、第三層6を貫通する貫通孔が形成されており、第四層7の中央 付近には、第四層7を貫通し第三層6の貫通孔よりも大きな開口の貫通孔が形成されてお り、これら貫通孔を形成する壁面によってキャビティが形成されている。そして、第三層 6の貫通孔内には、平面視略長方形の板状のガス検出素子 8, 9が並列に配置されて、第 三層5の上面に接着されている。尚、第三層6の貫通孔を形成する壁面とガス検出素子8 ,9との間、或いは、各ガス検出素子8,9の間には、内圧調整用窪み5A内の気圧が高 まった場合に、内圧調整用窪み5A内の空気を外部に放出して、外気圧と同じにするため の内圧放出孔6E,6F,6Gが形成されている。さらに、図1及び図5に示すように、 第三層 6 上には第四層 7 が積層され、当該第四層 7 には、平面視、略長方形の開口部 7 A が形成され、ガス検出素子8,9が露出するようになっている。

[0016]

次に、図1、図4~図6を参照して、ガス検出素子8、9の構造を説明する。図6は、 ガス検出素子8のガス検出部12の平面図である。これらのガス検出素子8,9には、各 々、ガスを検出する平面視略正方形のガス検出部 1 2 , 1 3 が形成され、その背面には、 図5に示すように、各々、窪み部6A,6Cが形成され、ダイアフラム構造部6B,6D となっている。尚、ダイアフラム構造部6B,6Dには、図示外のPt配線から構成され たマイクロヒータが組み込まれている。また、図4に示すように、ガス検出部12は、略 縦長の長方形のガス検出素子8の上面において、後側の側面2Q寄りに設けられている。 ガス検出部13もガス検出素子9の上面に同様に配置されている。ガス検出素子8のガス 検出部12は、図6に示すように、平面視、略正方形であり、その中央部には、図示外の ガス感応膜に接して形成された検知電極12Aが設けられている。また、ガス検出部13 もガス検出部12と同様の構造となっている。

[0017]

さらに、図1及び図4に示すように、ガス検出素子8の上面の短手側の側面2P寄りの 部分(図4における手前側の部分)には、ガス検出素子8の出力を外部に取り出すため及 びガス検出素子8への電源供給のための接続電極14A,14B,14C,14Dの電極 パッドが形成されている。また、同様に、ガス検出素子9の上面の短手側の側面2P寄り

の部分には、接続電極 15A, 15B, 15C, 15Dの電極パッドが形成されている。さらに、接続電極 14A \sim 14D, 15A \sim 15D 近傍の第三層 6 の上面には、接続電極 16A, 16B, 18A, 18B及びコモン電極 17 の電極パッドが設けられている。接続電極 14A, 14B, 15C, 15D は、接続電極 16A, 16B, 18A, 18B に、各々、Auワイヤ 20A, 20B, 21C, 21D によりワイヤボンディング接続され、接続電極 14C, 14D, 15A, 15B は、コモン電極 17 に、Auワイヤ 20C, 20D, 21A, 21B によりワイヤボンディング接続されている。

[0018]

[0019]

次に、ガス検出素子8,9の製造工程の概略を説明する。まず、ガス検出素子8,9の 基材となるシリコンウェハの洗浄を行う。次いで、そのシリコンウェハ上に酸化ケイ素膜 の形成、窒化ケイ素膜の形成を行う。次に、マイクロヒータを形成する。一例として、ス パッタリングによるTa層の形成後、Pt層を形成し、フォトリソグラフィによりパター ニングを行い、エッチング処理でマイクロヒータを形成する。その後、マイクロヒータを 覆うように窒化ケイ素膜を形成する。次いで、マイクロヒータの端部にマイクロヒータコ ンタクト部を形成する。一例としては、窒化ケイ素膜のエッチングを行い、マイクロヒー タコンタクト部を形成する。次に、マイクロヒータの上部に検知電極を形成する。一例と しては、スパッタリングによるTi層の形成後、Pt層の形成を行い、フォトリソグラフ ィによりパターニングを行い、エッチング処理で検知電極を形成する。次いで、検知電極 及びマイクロヒータの端部にコンタクトパッド(接続電極14A~14D,15A~15 D) の形成を行う。一例としては、スパッタリングによるCr層の形成後、Au層の形成 を行い、フォトリソグラフィによりパターニングを行い、エッチング処理で接続電極14 A~14D, 15A~15Dの形成を行う。次いで、シリコンの異方性エッチングによる ダイアフラム構造部6B,6Dの形成、ガス感応膜の形成を行う。その後、シリコンウェ ハの切断を行いガス検出素子8,9を切り出す。

[0020]

次に、図1~図3,図7及び図8を参照して、保護キャップ3の構造を説明する。図7は、図2に示すC-C線断面に於けるガスセンサ1の保護キャップ3のみの矢視方向断面であり、図8は、図2に示すC-C線断面に於けるガスセンサ1の矢視方向断面である。図1,図2,図7及び図8に示すように、保護キャップ3は、ステンレス鋼板をプレス成型して形成されており、平面視、略長方形の頂部30と、当該頂部30の長手方向端面から各々頂部30と直交し配線基板2の外側面に沿うように下方に折り曲げられた垂下突起部41,42から構成されている。

[0021]

この垂下突起部 4 1, 4 2 は、各々、略長方形の板状に形成されており、その下端部には、各々、嵌合突起 4 1 A, 4 2 A が内側に向けてプレス成型により打ち抜かれて突出している。この嵌合突起 4 1 A, 4 2 A は、図 3 及び図 8 に示すように配線基板 2 の外側面

のうちの対向する2面に各々設けられた嵌合部4A, 4Bに各々嵌合するようになってい る。尚、保護キャップ3の配線基板2への装着時には、垂下突起部41,42が、配線基 板2の長手方向外側面に各々設けられている案内凹部2A,2Bに案内されて、保護キャ ップ3の頂部30の裏面が第四層7の上面に当接するまで押し込まれて、垂下突起部41 ,42に各々設けられている嵌合突起41A,42Aが嵌合部4A,4Bに各々嵌合する 。すると、保護キャップ3が、配線基板2に装着固定される。

[0022]

次に、保護キャップ3の頂部30に設けられた通気孔31~39の配置について説明す る。図1及び図2に示すように、保護キャップ3の頂部30には、被測定ガスがガスセン サ1の内部に入るための平面視、略円形の通気孔31~39が穿設されている。この通気 孔31~39は、無作為に設けられているのではなく、通気孔31~39及びダイヤフラ ム構造部 6 B, 6 Dをガス検出素子 8, 9 の表面を水平に延設した平面に正射影した場合 に、通気孔31~39の正射影像がダイヤフラム構造部6B,6Dの正射影像に重ならな いように、ダイヤフラム構造のガス検出部12,13の真上を避けて通気孔31~39が 配置されている。即ち、保護キャップ3の頂部30に垂直に視線を置いた場合には、通気 孔31~39からは、ガス検出部12,13を目視することができないように通気孔31 ~39が保護キャップ3の頂部30に配置されている。従って、異物が空気中を落下して きて、通気孔31~39を通過しても、異物が直接的にガス検出部12,13に衝突しな いようになっている。よって、ガス検出部12,13への異物の付着を防止でき、また、 極薄いダイアフラム構造部6B、6Dが異物の衝突により破損することを防止できる。

[0023]

さらに、保護キャップ3の頂部30には、チップマウンタの吸着ノズルの当接可能な平 面部30Aが形成されている。従って、ガスセンサ1は、保護キャップ3の頂部30に、 チップマウンタの吸着ノズルの当接可能な平面部30Aを有し、配線基板2の第一層4の 底面1Aは、略長方形の平面に形成されており、略長方形の外部電極51A,51B,5 1C, 51D, 51E, 51Fが設けられているので、ガスセンサ1を小型化できると共 に、回路基板に電子部品を実装する際にチップマウンタを用いてガスセンサ1の表面実装 が同時に可能である。

[0024]

さらに、保護キャップ3の頂部30に設けられた通気孔31~39は、ガス検出素子8 , 9の表面を水平に延設した平面に、通気孔31~39及び接続部であるAuワイヤ20 A, 20B, 20C, 20D, 21A, 21B, 21C, 21Dを正射影した場合に、通 気孔31~39の正射影像が接続部であるAuワイヤ20A,20B,20C,20D, 21A, 21B, 21C, 21Dの正射影像に重ならないように、配置されている。即ち 、通気孔31~39がAuワイヤ20A, 20B, 20C, 20D, 21A, 21B, 2 1C, 21D(接続部)の真上を避け配置されている。このようにすることにより、通気 孔31~39からガスセンサ1内へ進入した異物がAuワイヤ20A,20B,20C, 20D, 21A, 21B, 21C, 21Dに付着しにくく、また、異物が接続部であるA uワイヤ20A, 20B, 20C, 20D, 21A, 21B, 21C, 21Dの間を短絡 させることを防止できる。

[0025]

尚、図2に示すように、通気孔31~39の正射影像が接続部であるAuワイヤ20A , 20B, 20C, 20D, 21A, 21B, 21C, 21Dの正射影像及び接続電極1 4A~14D, 15A~15D、接続電極16A, 16B, 18A, 18B, コモン電極 17の正射影像に重ならないように通気孔31~39を配置しても良い。この場合には、 通気孔31~39からガスセンサ1内へ進入した異物がAuワイヤ20A,20B,20 C, 20D, 21A, 21B, 21C, 21Dだけでなく、接続電極14A~14D, 1 5A~15D、接続電極16A, 16B, 18A, 18B, コモン電極17に付着しにく く、また、異物がこれらの電極間を短絡させることがない。よって、電極間の短絡による ガスセンサ1の出力不良を防止できる。

[0026]

さらに、保護キャップ3には、図2に示すように、ガスセンサ1を図示外の回路基板等にマウントする時に、ガスセンサ1の向きを確認できるように、方向性の確認用の窪み40が設けらている。この窪み40は、保護キャップ3を平面視した場合に、保護キャップ3の一方の長辺の中央部の左寄りに、平面視、略円弧状に形成されている。

[0027]

以上説明したように、本実施の形態のガスセンサ1では、センサ素子を搭載した積層構造の配線基板2の第一層4に形成された窪み部である嵌合部4A,4Bに、保護キャップ3の垂下突起部41,42に設けられた嵌合突起41A,42Aを嵌合させて、保護キャップ3を配線基板2に固定することができる。従って、配線基板2に保護キャップ3を容易に装着できるので、配線基板に対する保護キャップの装着工程が複雑化しない。また、少なくとも配線基板2の外側面のうちの対向する2面に設けられている嵌合部4A,4Bに、保護キャップ3の垂下突起部41,42を嵌合させるので、確実に保護キャップ3を配線基板2に固定することができる。さらに、配線基板2に設けられた案内凹部2A,2Bにより、垂下突起部41,42を嵌合部4A,4Bに嵌合突起41A,42Aが嵌合する位置まで案内するので、保護キャップ3の配線基板2への固定が容易にできる。

[0028]

尚、本発明は、上記の実施の形態に限られず、各種の変形が可能である。例えば、嵌合部 4 A, 4 B は、最下層に設けたものに限られず、図 9 に示すように、第二層 5 に嵌合部 5 A, 5 B を設けても良い。また、図 1 0 に示すように、第三層 6 に嵌合部 6 H, 6 I を設けても良い。即ち、嵌合部は、配線基板 2 の最上層以外の層に設けることができる。

[0029]

また、ガスセンサ1の配線基板2は4層の積層構造となっているが、必ずしも4層構造に限られず、2層、3層、5層、6層等の複数層の積層構造であれば良い。また、ガスセンサ1は、ガス検出素子を2つ組み込んでいるが、これは、1つでも、3つでも良い。さらに、配線基板2の材質は、セラミックに限られず、プラスチックでも良い。また、保護キャップ3の材質は、ステンレス鋼板に限られず、鉄、アルミ、銅等の各種の金属及びプラスチックでも良い。

[0030]

尚、配線基板2及び保護キャップ3の材質がプラスチックの場合、配線基板2の対向する側面に突起部を形成し、保護キャップ3の垂下突起部41,42に窪み又は孔を設けて、前記突起部と嵌合するようにしても良い。

[0031]

さらに、案内凹部 2 A, 2 B は左右で幅を異ならせ、垂下突起部 4 1, 4 2 もその幅に合うように左右で幅を異ならせても良い。この場合には、保護キャップ 3 を左右向きを誤って配線基板 2 に装着させることを防止できる。

[0032]

尚、センサ素子としては、例えば、シリコンダイアフラム構造のエアフローセンサ、シリコンダイアフラム構造の熱伝導式ガスセンサ、シリコンダイアフラム上にパラジウム等の触媒層を設けた接触燃焼式ガスセンサ、シリコンダイアフラム上に酸化スズ等の金属酸化物半導体層を設けたガスセンサ等が挙げられる。

【産業上の利用可能性】

[0033]

本発明は、センサ素子実装パッケージに適用でき、ガスセンサのパッケージに限られず、各種の半導体素子のパッケージに適用できる。

【図面の簡単な説明】

[0034]

- 【図1】本発明の一実施の形態のガスセンサ1の分解斜視図である。
- 【図2】ガスセンサ1の平面図である。

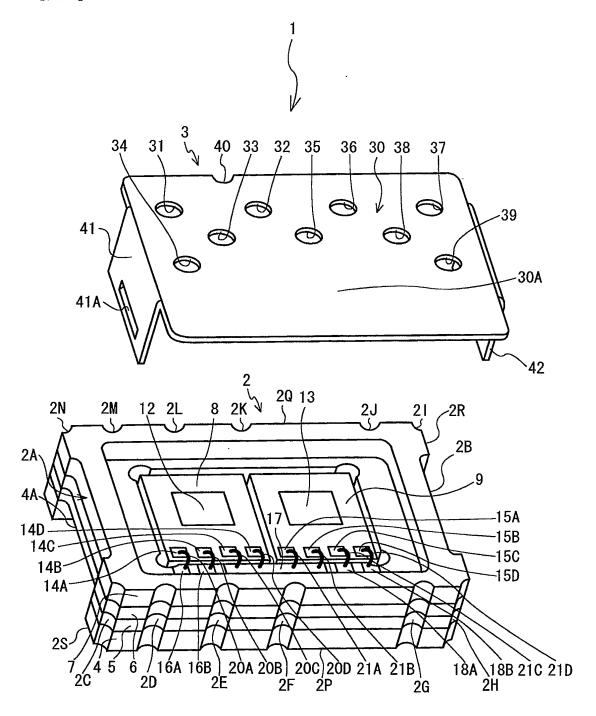
- 【図3】ガスセンサ1の底面図である。
- 【図4】配線基板2の平面図である。
- 【図5】図4のA-A線断面に於ける配線基板2の矢視方向断面図である。
- 【図6】ガス検出素子8のガス検出部12の平面図である。
- 【図7】図2に示すC-C線断面に於けるガスセンサ1の保護キャップ3のみの矢視方向断面である。
- 【図8】図2に示すC-C線断面に於けるガスセンサ1の矢視方向断面である。
- 【図9】配線基板2の嵌合部の変形例の縦断面図である。
- 【図10】配線基板2の嵌合部の変形例の縦断面図である。

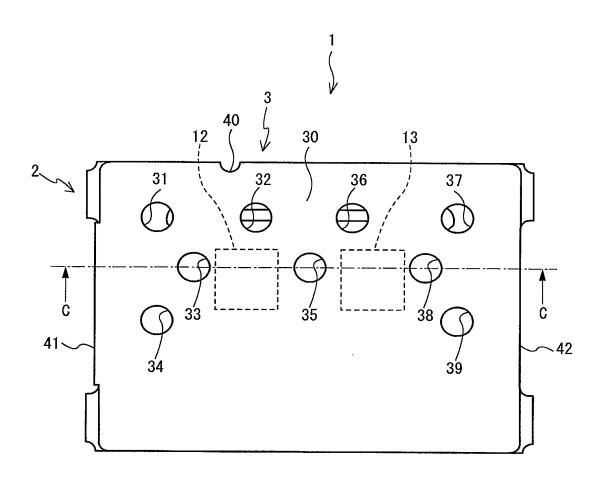
【符号の説明】

[0035]

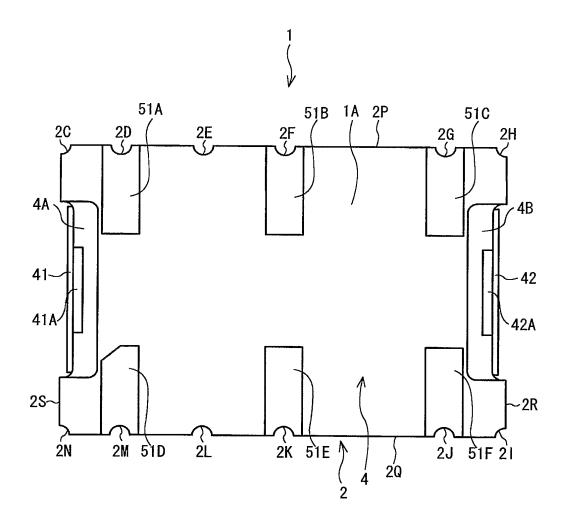
- 1 ガスセンサ
- 2 配線基板
- 3 保護キャップ
- 4 第一層
- 4 A, 4 B 嵌合部
- 5 第二層
- 5 A, 5 B 嵌合部
- 6 第三層
- 6 B, 6 D ダイアフラム構造部
- 6 E, 6 F 嵌合部
- 7 第四層
- 8,9 ガス検出素子
- 12 ガス検出部
- 12A 検知電極
- 13 ガス検出部
- 3 0 頂部
- 3 0 A 平面部
- 31~39 通気孔
- 41,42 垂下突起部
- 4 1 A, 4 2 A 嵌合突起

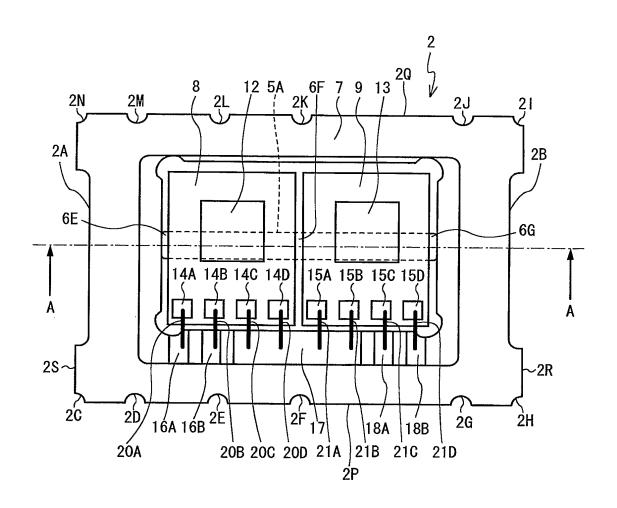
【書類名】図面【図1】



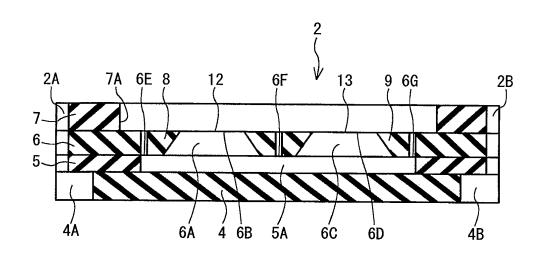


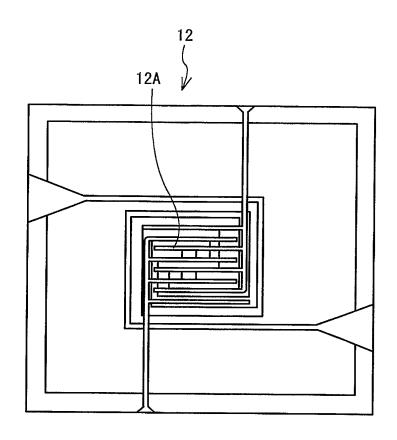
【図3】

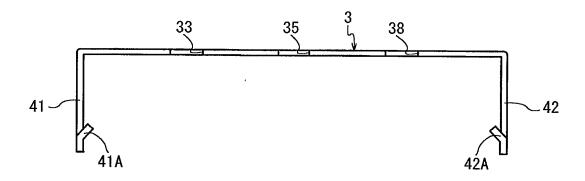


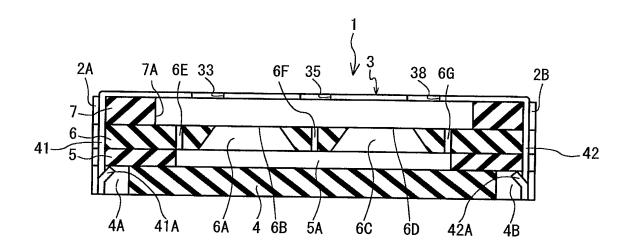


【図5】

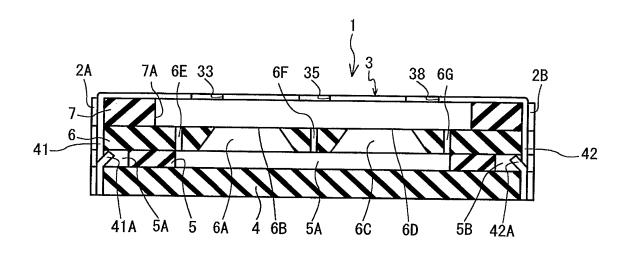




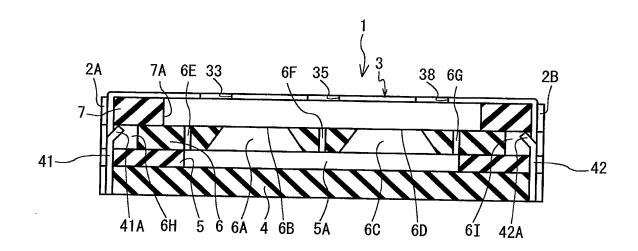




【図9】



【図10】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 センサ素子実装パッケージの配線基板に対する保護キャップの装着工程が複雑化せず、配線基板に保護キャップを容易に装着することができるセンサ素子実装パッケージを実現する。

【解決手段】 保護キャップ3は、ステンレス鋼板をプレス成型して形成されており、平面視、略長方形の頂部30と、当該頂部30の長手方向端面から各々頂部30と直交するように下方に折り曲げられた垂下突起部41,42とから構成され、この垂下突起部41,42は、各々、略長方形の板状に形成されており、その下端部には、各々、嵌合突起41A,42Aが内側に向けてプレス成型により打ち抜かれて突出している。この嵌合突起41A,42Aは、配線基板2の外側面のうちの対向する2面に各々設けられた嵌合部4A,4Bに各々嵌合して、保護キャップ3が、配線基板2に装着固定される。

【選択図】 図8

特願2003-401382

出願人履歷情報

識別番号

[000004547]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月 8日 新規登録

住所氏名

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号

日本特殊陶業株式会社